

Der Transistor GS 110 ist ein Germaniumtransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11 811 mit 10 mm Kappenhöhe.
Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor mittlerer Leistung.

Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ grad}$)

Kollektorrestströme

$$\begin{aligned} -I_{CEBO} &\leq 15 \mu\text{A} \quad (\text{bei } -U_{EB} = 10 \text{ V}) \\ -I_{CER} &\leq 300 \mu\text{A} \quad (\text{bei } -U_{CE} = 15 \text{ V}) \quad \text{bei } R_{BE} = 10 \text{ k}\Omega \\ -I_{CBO} &\leq 25 \mu\text{A} \quad (\text{bei } -U_{CB} = 20 \text{ V}) \\ -I_{CBO} &\leq 15 \mu\text{A} \quad (\text{bei } -U_{CB} = 15 \text{ V}) \end{aligned}$$

Restspannung

$$\begin{aligned} -U_{CE\text{rest}} &= 0,36 \leq 0,55 \text{ V} \quad (\text{bei } -I_C = 300 \text{ mA}) \\ -U_{CE\text{sat}} &= 0,15 \leq 0,3 \text{ V} \quad (\text{bei } -I_C = 300 \text{ mA}, -I_B = 9,4 \text{ mA}) \end{aligned}$$

Gleichstromverstärkung (bei $-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$, $-I_C = 300 \text{ mA}$)
(impulsmäßig gemessen)

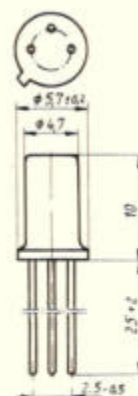
B_N	I	29—55
	II	45—88
	III	72—143
	IV	117—231

Schaltzeitkonstante

$$\tau_i \leq 1,5 \mu\text{s} \quad (\text{bei } -I_C = 200 \text{ mA}, -U_{CE} = 0,50 \text{ V})$$



Abmessungen



Masse 0,7 g

Grenzwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)

$$\begin{aligned} -U_{CB} &= 30 \text{ V}^1) \\ -U_{EB} &= 10 \text{ V} \\ -U_{CER} &= 15 \text{ V} \quad (R_{BE} = 10 \text{ k}\Omega) \\ -I_C &= 200 \text{ mA} \\ -\dot{I}_C &= 300 \text{ mA} \\ -I_E &= 220 \text{ mA} \\ -\dot{I}_E &= 330 \text{ mA} \\ P_C &= 85 \text{ mW} \quad (45^\circ\text{C}) \\ \vartheta_j &= 85^\circ\text{C} \end{aligned}$$

¹⁾ Siehe Diagramm $-U_{CE} = f(R_{BE})$.

Bestellbezeichnung
für einen Transistor:
Transistor GS 110

